

トランジスタ

T-33-17 2SA900

2SA900

シリコン PNP エピタキシャルプレーナ形/Si PNP Epitaxial Planar

低周波電力増幅用/AF Power Amplifier

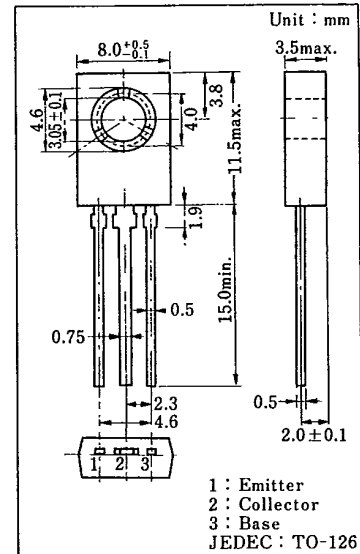
2SC1568 とコンプリメンタリ/Complementary Pair with
2SC1568

■ 特 徴/Features

- コレクタ・エミッタ飽和電圧 $V_{CE(sat)}$ が低い。/ Low $V_{CE(sat)}$
- 放熱板への取付けに絶縁板を必要としない TO-126 パッケージです。/
TO-126 package, no insulator needed when fixing to a heat sink.

■ 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	$-V_{CBO}$	20	V
コレクタ・エミッタ電圧	$-V_{CEO}$	18	V
エミッタ・ベース電圧	$-V_{EBO}$	5	V
せん頭コレクタ電圧	$-I_{CP}$	2	A
コレクタ電流	$-I_C$	1	A
コレクタ損失	P_C	1.2	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	$-55 \sim +150$	$^\circ\text{C}$

■ 電氣的特性/Electrical Characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタシャ断電圧	$-I_{CBO}$	$-V_{CB}=10\text{ V}, I_E=0$			1	μA
	$-I_{CEO}$	$-V_{CE}=18\text{ V}, I_B=0$			10	
コレクタ・ベース電圧	$-V_{CBO}$	$-I_C=10\text{ }\mu\text{A}, I_E=0$	20			V
コレクタ・エミッタ電圧	$-V_{CEO}$	$-I_C=1\text{ mA}, I_B=0$	18			V
エミッタ・ベース電圧	$-V_{EBO}$	$-I_E=10\text{ }\mu\text{A}, I_C=0$	5			V
直流電流増幅率	h_{FE1}^*	$-V_{CE}=2\text{ V}, -I_C=500\text{ mA}$	90		470	
	h_{FE2}	$-V_{CE}=2\text{ V}, -I_C=1.5\text{ A}$	50			
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$-V_{CE(sat)}$	$-I_C=1\text{ A}, -I_B=50\text{ mA}$			0.5	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$-V_{BE(sat)}$	$-I_C=500\text{ mA}, -I_B=50\text{ mA}$			1.2	V
トランジション周波数	f_T	$-V_{CB}=6\text{ V}, I_E=50\text{ mA}$		200		MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$-V_{CB}=6\text{ V}, I_E=0, f=1\text{ MHz}$		40		pF

* h_{FE1} ランク分類/ h_{FE1} Classifications

Class	Q	R	S	T	U
h_{FE1}	90~155	130~210	180~280	250~360	330~470

